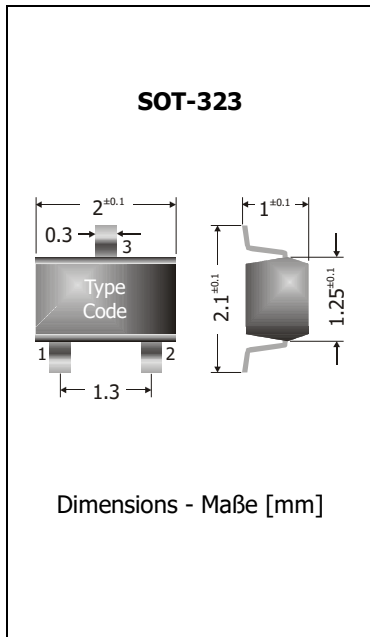


BAS16W, BAW56W, BAV70W, BAV99W, BAV199W SMD Small Signal Diodes SMD Kleinsignal-Dioden	I_{FAV} = 150 mA	V_{RRM} = 85 V
	V_{F1} < 0.715 V	I_{FSM1} = 2 A
	T_{jmax} = 150°C	t_{rr} < 4 ns

Version 2019-06-26



Typical Applications

Signal processing, High-speed Switching, Rectifying
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾

Features

Very high switching speed
 Low junction capacitance
 Low leakage current
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions



3000 / 7"
 0.01 g
 UL 94V-0
 260°C/10s
 MSL = 1

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung, Schnelles Schalten, Gleichrichten
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

Extrem schnelles Schalten
 Niedrige Sperrschichtkapazität
 Niedriger Sperrstrom
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

BAS16W Single Diode Type Code A6 1 = A 2 = n. c. 3 = C	BAV70W Common Cathode Type Code PH 1 = A1 2 = A2 3 = C1/C2
BAW56W Common Anode Type Code YX 1 = C1 2 = C2 3 = A1/A2	BAV99W BAV199W/-AQ Series Connection Type Code A7 JY 1 = A1 2 = C2 3 = C1/A2

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

Power dissipation (per device) – Verlustleistung (pro Bauteil)	P _{tot}	200 mW ³⁾
Maximum forward current, single diode loaded Dauergrenzstrom, eine Diode belastet	BAS16W, BAW56W, BAV99W BAV199W-AQ BAV70W	I _{FAV} 150 mA ³⁾ 160 mA ³⁾ 175 mA ³⁾
Maximum forward current, both diodes loaded Dauergrenzstrom, beide Dioden belastet	BAV199W-AQ BAW56, BAV99 BAV70W	I _{FAV} 140 mA ³⁾ 125 mA ³⁾ 100 mA ³⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	I _{FRM}	300 mA ³⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 s t _p ≤ 1 ms t _p ≤ 1 μs	I _{FSM} 0.5 A 1 A 2 A

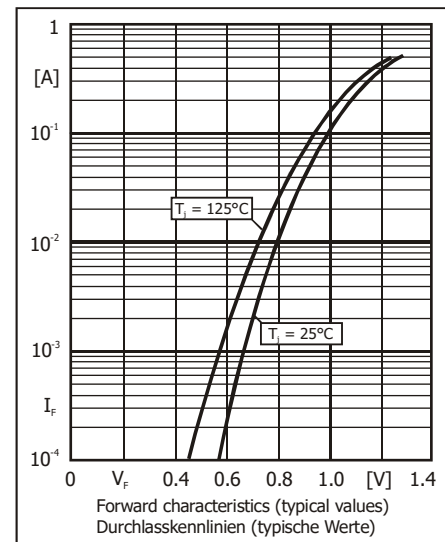
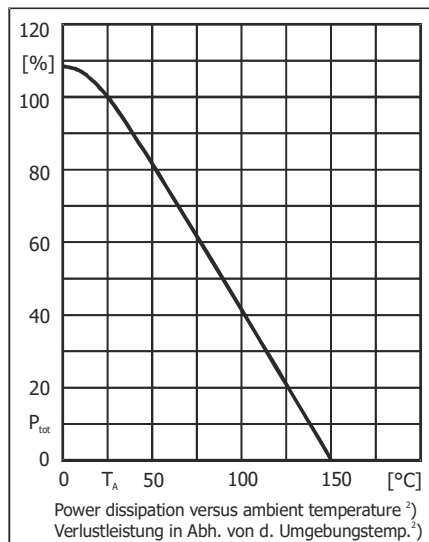
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
 2 T_A = 25°C and per diode, unless otherwise specified – T_A = 25°C und pro Diode, wenn nicht anders angegeben
 3 Mounted on 3 mm² copper pads per terminal – Montage auf 3 mm² Kupferbelag (Löt pads) je Anschluss

Maximum ratings ¹⁾
Grenzwerte ²⁾

Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung		BAS16W, BAW56W, BAV99W, BAV199W-AQ BAV70W	V_{RRM}	85 V 100 V
Reverse voltage Sperrspannung	DC	BAS16W, BAW56W, BAV99W, BAV70W BAV199W-AQ	V_R	75 V 85 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T_j T_s	-55...+150°C

Characteristics
Kennwerte

		BAS16W BAW56W BAV99W	BAV70W	BAV199W/-AQ
Forward voltage Durchlass-Spannung ²⁾	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F =$ 1 mA 10 mA 50 mA 150 mA	V_F	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V	< 900 mV < 1.0 V < 1.1 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom ¹⁾	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R =$ 25 V 75 V	I_R	< 30 nA < 1.0 μA	– < 5 nA
	$T_j = 150^\circ\text{C}$ $V_R =$ 25 V 75 V	I_R	< 30 μA < 50 μA	– < 80 nA
Junction capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_T	< 2 pF	typ 2 pF
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 10\text{ mA}$ über/through $I_R = 10\text{ mA}$ bis/to $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	< 4 ns	< 3000 ns
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung		R_{thA}	400 K/W ³⁾	



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- $T_A = 25^\circ\text{C}$ and per diode, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ und pro Diode, wenn nicht anders angegeben
- Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$
Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- Mounted on 3 mm² copper pads per terminal
Montage auf 3 mm² Kupferbelag (Löt pads) je Anschluss